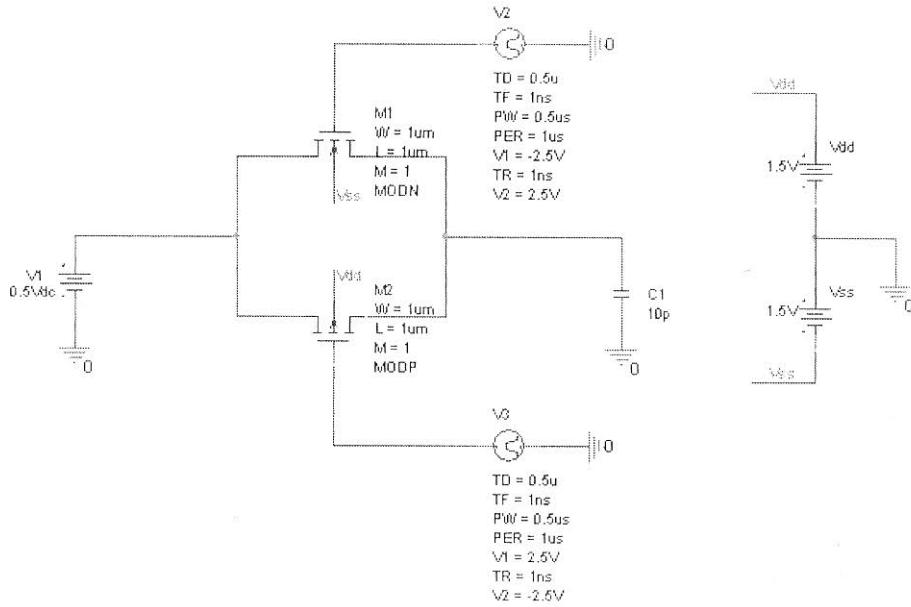
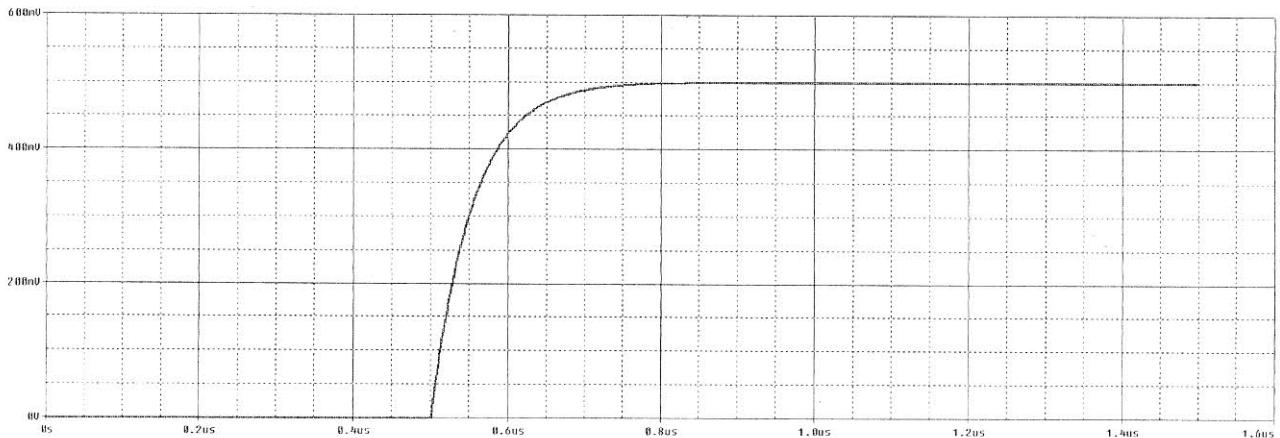


## ELETRÔNICA II – 4<sup>a</sup> LISTA – GABARITO

**[Questão 01]** O objetivo desta questão é realizar um estudo da chave analógica complementar, construída com transistores MOS. Abaixo, é apresentado o diagrama esquemático do circuito simulado nesta questão:

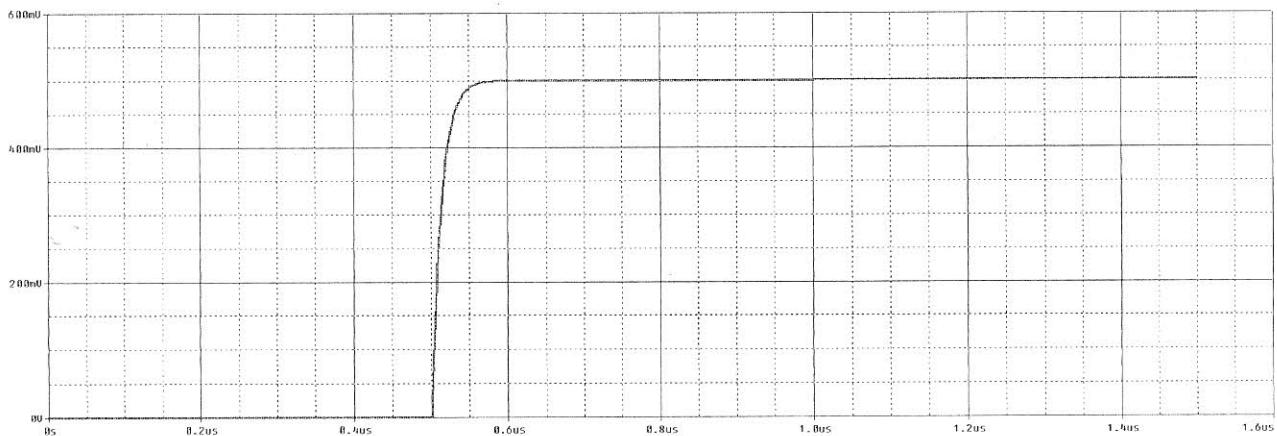


- (a)** Simulando o circuito no intervalo de 1,5  $\mu$ s, obtém-se o seguinte gráfico para a tensão na saída vo:



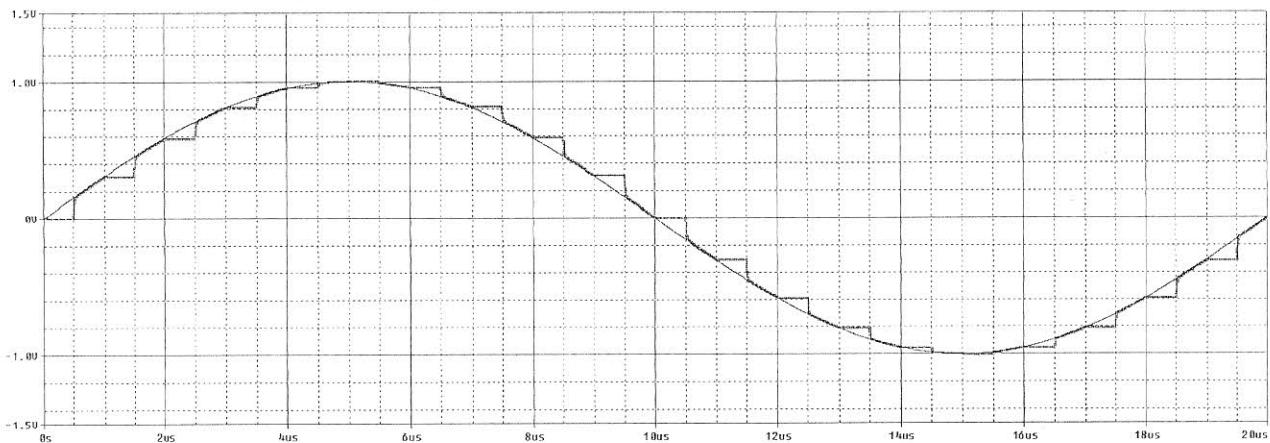
No gráfico apresentado acima, verifica-se o crescimento exponencial da tensão no capacitor de carga assim que a chave é fechada, fazendo com que o capacitor seja carregado com a mesma tensão de 0,5 V aplicada à entrada. Nota-se, também, que a tensão no capacitor se mantém quando a chave é aberta, funcionando como um elemento de memória analógica.

**(b)** Simulando o mesmo circuito acima, com a largura de ambos os transistores alterada para  $4\mu\text{m}$ , obtém-se o seguinte gráfico para a tensão na saída:



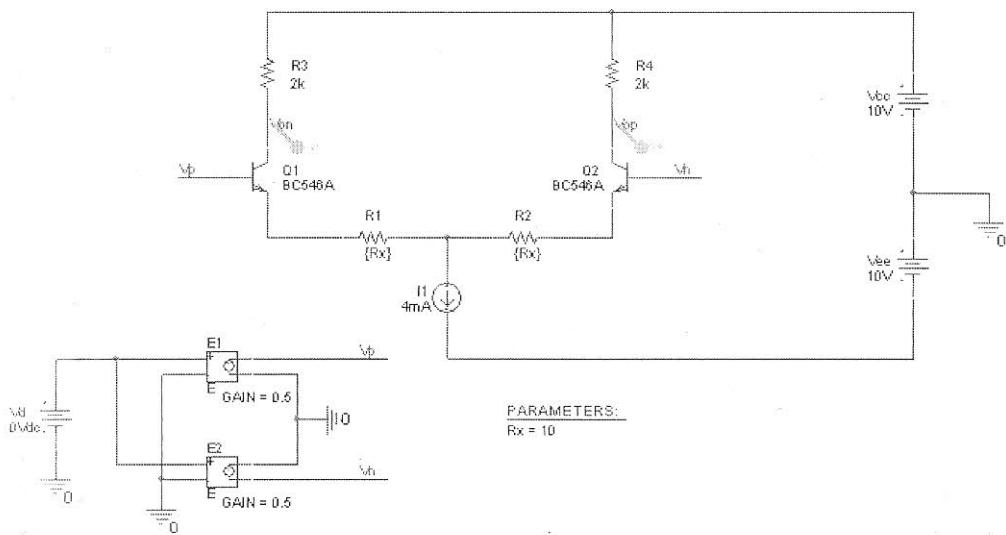
De acordo com os resultados obtidos, nota-se, novamente, que a tensão no capacitor evoluiu exponencialmente até 0,5 V. Entretanto, a diferença ficou por conta do tempo de carregamento, que foi significativamente menor nessa segunda simulação. Essa diferença se deve à menor resistência equivalente da chave analógica, em virtude do aumento da largura dos transistores. A redução na resistência equivalente da chave analógica faz com que a constante de tempo RC do circuito diminua, encurtando o tempo de carregamento do capacitor de carga.

**(c)** Esta simulação é um exemplo do uso do circuito acima como um *sample-and-hold*. O objetivo é amostrar o valor da tensão na entrada em instantes periódicos de tempo, retraindo seu valor no intervalo em que a chave fica aberta. Assim, usando uma senóide como sinal de entrada, obtém-se como resultado o gráfico abaixo:



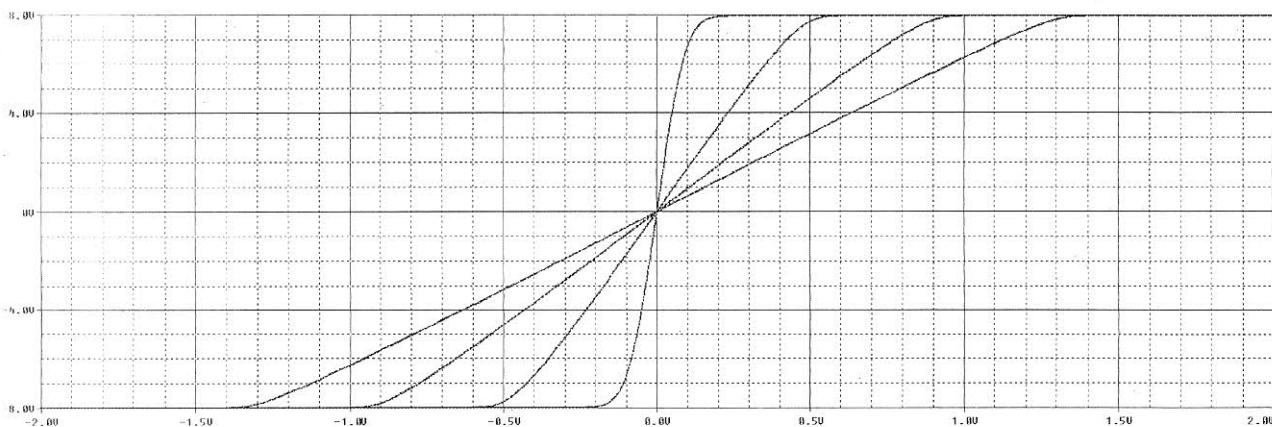
Nesse gráfico, temos a forma de onda do sinal de entrada, juntamente com a forma de onda do sinal de saída. Conforme o esperado, nos intervalos de tempo em que a chave analógica está fechada, a tensão na saída acompanha o sinal de entrada. Entretanto, a tensão na saída é mantida constante nos intervalos em que a chave é aberta, memorizando a tensão amostrada.

**[Questão 02]** O objetivo desta questão é mostrar como a adição de resistores de degeneração de emissor pode estender os limites da tensão de entrada em que um par diferencial bipolar opera de maneira razoavelmente linear. O circuito simulado aqui é apresentado abaixo:



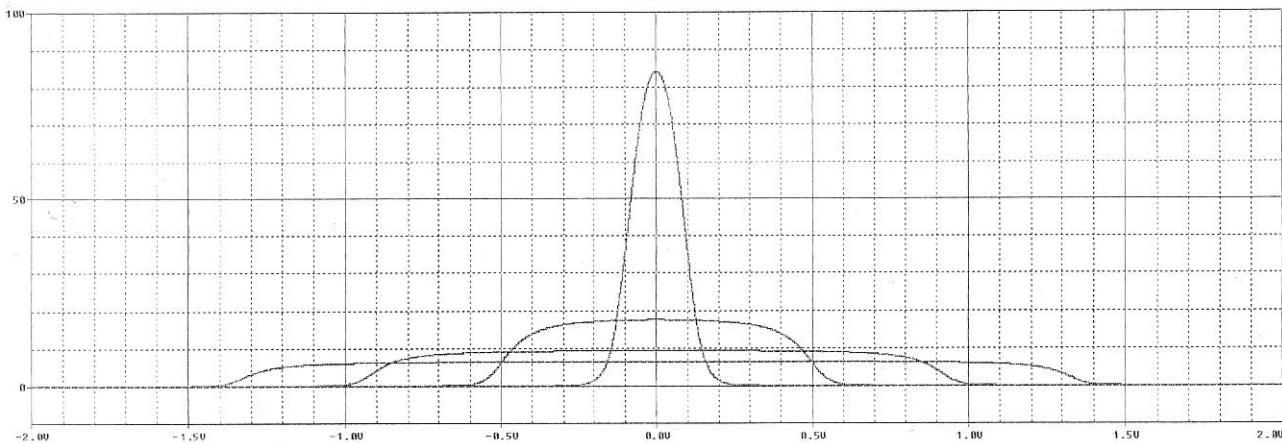
Nesse circuito, os valores dos resistores de degeneração de emissor foram definidos como sendo iguais ao valor de uma variável  $R_x$ .

- (a) A fim de se obter a curva característica de transferência de tensão entre a entrada diferencial e a saída do amplificador, foi simulada uma varredura na tensão diferencial de entrada a partir de -2 V a até +2 V. Assim, obtivemos as curvas abaixo de como varia a tensão na saída em função da tensão diferencial de entrada.



Cada uma das curvas acima foi obtida para um determinado valor dos resistores de degeneração de emissor. De acordo com os resultados, nota-se que quanto maior o valor dos resistores de degeneração, maior é a faixa da tensão de entrada em que o par diferencial opera de maneira aproximadamente linear. Entretanto, o preço a ser pago por esse aumento na faixa de operação linear é a redução do ganho de tensão do amplificador diferencial, em virtude da diminuição da inclinação da curva no trecho "linear".

**(b)** Para obter o valor do ganho de tensão do amplificador diferencial para cada valor de resistor de degeneração, devemos obter a derivada de cada uma das curvas características apresentadas acima:



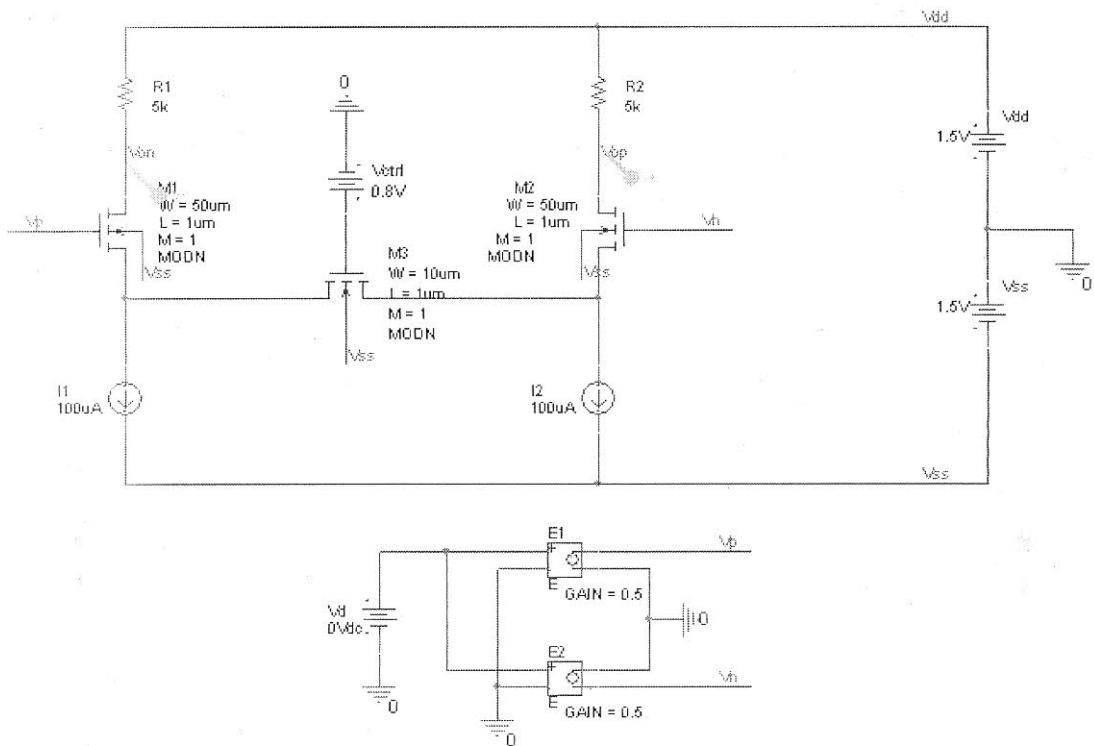
Observando as derivadas, nota-se que quanto mais baixo o ganho, maior é a faixa da tensão diferencial de entrada em que a derivada é constante, ou seja, a faixa em que o par diferencial opera linearmente.

Na tabela abaixo, temos os valores de ganho medidos em  $v_d = 0$ , a partir das derivadas das curvas características traçadas para diferentes valores dos resistores de degeneração de emissor.

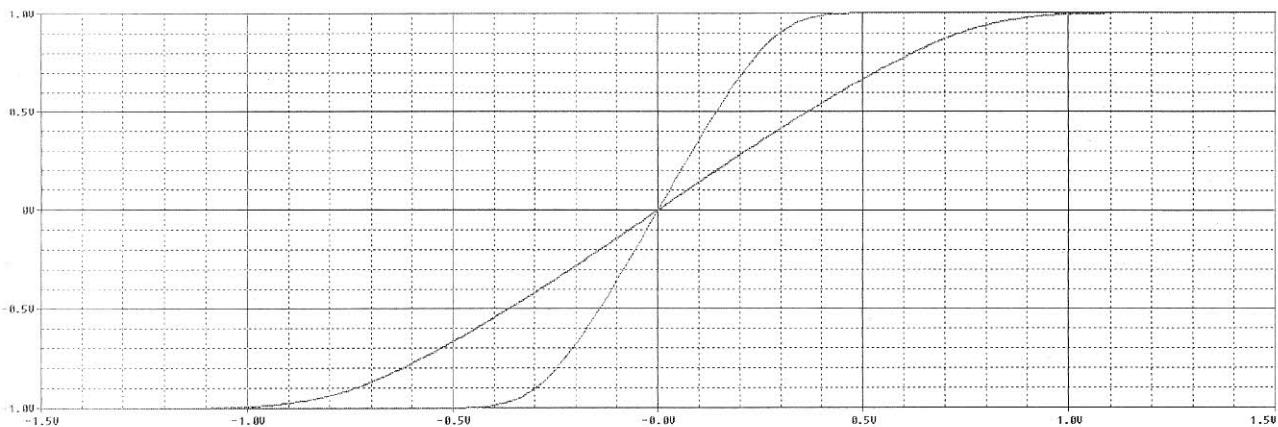
<i>Resistores de Degeneração (<math>\Omega</math>)</i>	<i>Ganho</i>
10	84,1
100	17,5
200	9,3
300	6,3

**(c)** Os cálculos referentes a este item são apresentados a seguir.

**[Questão 03]** O amplificador diferencial desta questão é similar ao da questão anterior. Uma das diferenças está no fato de que o par diferencial é implementado com transistores MOS, ao invés de transistores bipolares. A principal diferença é que, ao invés de empregar resistores de degeneração, emprega-se um transistor MOS operando na região de triodo como elemento de degeneração de fonte. Esse transistor de degeneração irá operar como um resistor, cuja resistência é controlada pela tensão de *gate*.



Realizando a varredura da tensão diferencial de entrada, serão obtidas duas curvas características para o amplificador diferencial acima. Uma para uma tensão de controle  $V_{CTRL}$  igual a 0 V e outra igual a 1,5 V. Ambas as curvas são apresentadas abaixo:

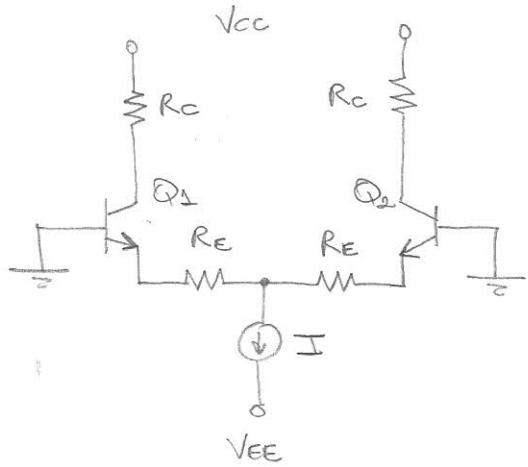


Nota-se que essas curvas apresentam um formato bem similar ao das curvas de transferência de tensão obtidas na questão anterior. Além disso, nota-se que tanto o ganho, como também a faixa de operação linear do par diferencial, variam ao se variar a tensão de *gate* do transistor de degeneração de fonte. Isso acontece porque o transistor de dege-

neração funciona como um resistor controlado pela própria tensão  $V_{CTRL}$ . Assim, ao se aumentar a tensão de controle, a resistência equivalente diminui, aumentando o ganho e reduzindo a faixa de operação linear do par diferencial.

A vantagem do circuito acima é que o ganho pode ser variado simplesmente alterando-se a tensão de controle  $V_{CTRL}$ , ao invés de trocar o valor de resistores, como no caso do par diferencial da questão anterior. Isso permite que o circuito acima seja usado em circuitos com controle automático de ganho.

② (c) Antes de realizar a análise de sinal, obtemos os parâmetros do modelo de sinal dos transistores a partir da análise DC:



Independentemente do valor de  $R_E$ , teremos que:

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I}{2} = 1 \text{ mA}$$

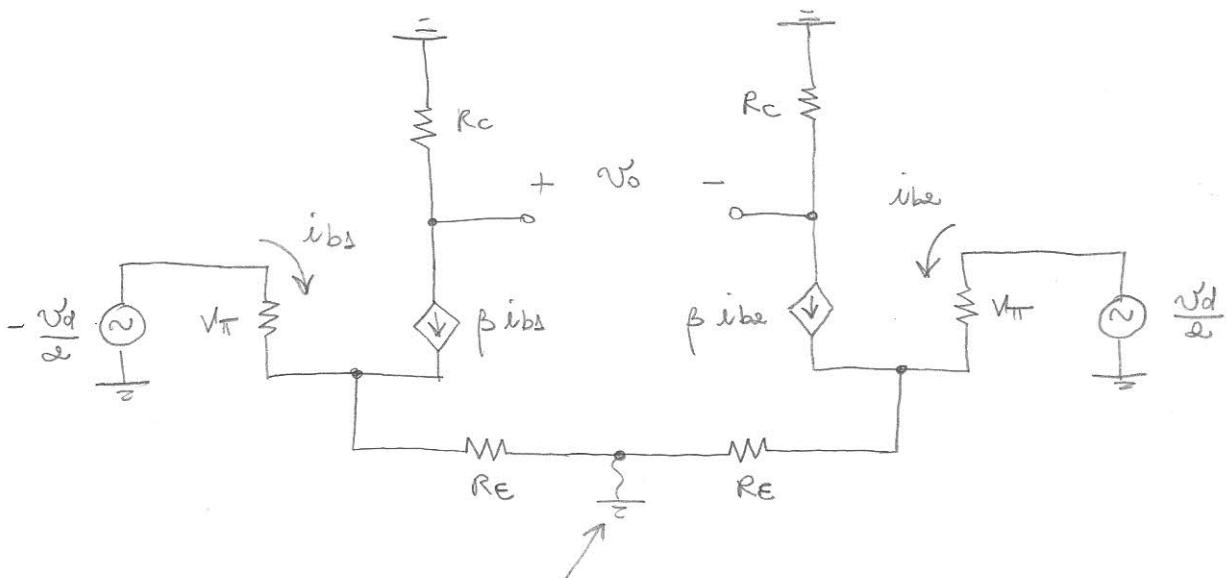
Então:

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+1} \cdot \frac{I}{2} = 1,98 \text{ mA}$$

Consequentemente:

$$\left\{ \begin{array}{l} g_m = \frac{I_C}{V_T} = 19,8 \text{ mA/V} \\ V_T = \frac{\beta}{g_m} = 1,26 \text{ k}\Omega \end{array} \right.$$

Assim, passamos para a análise de sinal para obter o ganho diferencial:



Fixa virtual, com virtude da simetria do circuito.

Centrás:

$$-\frac{v_d}{\omega} = i_{bs} V_T + (\beta + \Delta) i_{bs} R_E$$

$$i_{bs} = -\frac{1}{V_T + (\beta + \Delta) R_E} \cdot \frac{v_d}{\omega}$$

$$\frac{v_d}{\omega} = i_{be} V_T + (\beta + \Delta) i_{be} R_E$$

$$i_{be} = \frac{1}{V_T + (\beta + \Delta) R_E} \cdot \frac{v_d}{\omega}$$

Assim:

$$v_o = v_{os} - v_{oe} = -\beta R_C i_{bs} + \beta R_C i_{be}$$

$$v_o = \frac{\beta R_C}{V_T + (\beta + \Delta) R_E} \cdot \frac{v_d}{\omega} + \frac{\beta R_C}{V_T + (\beta + \Delta) R_E} \cdot \frac{v_d}{\omega}$$

$$\Rightarrow A_{vd} = \frac{v_o}{v_d} = \frac{\beta R_C}{V_T + (\beta + \Delta) R_E}$$

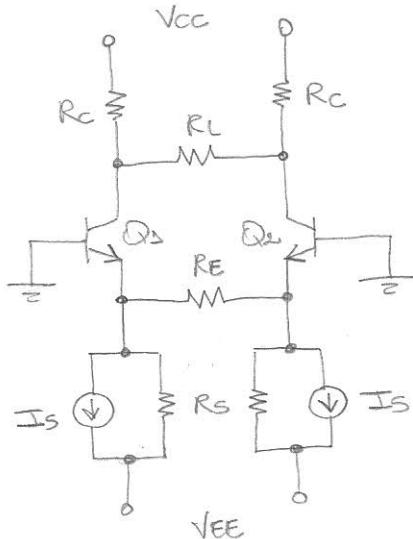
Substituindo os valores numéricos na expressão acima,  
teremos que:

$R_E (\Omega)$	$A_{vd}$
50	462,3
100	18,73
200	9,65
300	6,5

Nota-se que quanto maior o valor de  $R_E$ , menor é o erro verificado entre o valor simulado e o calculado teoricamente para a ganho de tensão diferencial. Isso acontece porque quanto maior o valor de  $R_E$ , menor será a dependência de  $A_{vd}$  com relação a  $\beta$ :

$$A_{vd} \approx \frac{\beta R_C}{(\beta + \Delta) R_E} \approx \frac{\cancel{\beta} R_C}{\cancel{\beta} R_E} = \frac{R_C}{R_E}$$

② (a) Começando a análise pelos cálculos dos pontos de operação:



Pela simetria do circuito, temos que os correntes em  $R_E$  e  $R_L$  são nulas.

Assim:

$$I_{E1} = I_{E2} = I_S + \frac{(-V_{BE} - V_{EE})}{R_S} = 1,044 \text{ mA}$$

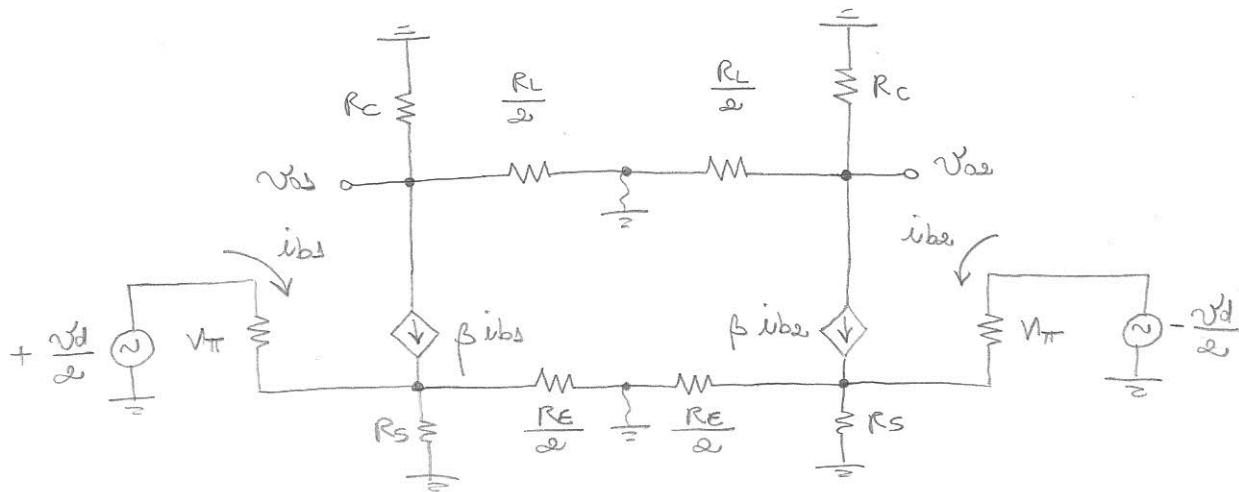
Logo:

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+1} I_{E1,2} = 1,034 \text{ mA}$$

Portanto, os parâmetros de pequenos sinais não dadas por:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_m = \frac{I_C}{V_T} = 43,35 \text{ mA/V} \\ V_{\pi} = \frac{\beta}{\alpha_m} = 0,42 \text{ k}\Omega \end{array} \right.$$

Então, procedemos os cálculos do ganho diferencial:



Pela simetria do circuito, temos os dois terra virtuais apresentados acima. dessa forma, considerando  $\frac{R_E}{2} \ll R_S$ :

$$\frac{V_d}{2} = V_{\pi} i_{b1} + (\beta+1) i_{b1} \frac{R_E}{2} \quad \therefore \quad i_{b1} = \frac{1}{V_{\pi} + (\beta+1) \frac{R_E}{2}} \cdot \frac{V_d}{2}$$

$$-\frac{V_d}{2} = V_{\pi} i_{b2} + (\beta+1) i_{b2} \frac{R_E}{2} \quad \therefore \quad i_{b2} = \frac{-1}{V_{\pi} + (\beta+1) \frac{R_E}{2}} \cdot \frac{V_d}{2}$$

Consequentemente:

$$v_{os} = -\beta i_{bs} R_C \parallel \frac{R_L}{2} = -\frac{\beta R_C \parallel \frac{R_L}{2}}{\sqrt{\pi} + (\beta+1) \frac{R_E}{2}} \cdot \frac{V_d}{2}$$

$$v_{od} = -\beta i_{be} R_C \parallel \frac{R_L}{2} = \frac{\beta R_C \parallel \frac{R_L}{2}}{\sqrt{\pi} + (\beta+1) \frac{R_E}{2}} \cdot \frac{V_d}{2}$$

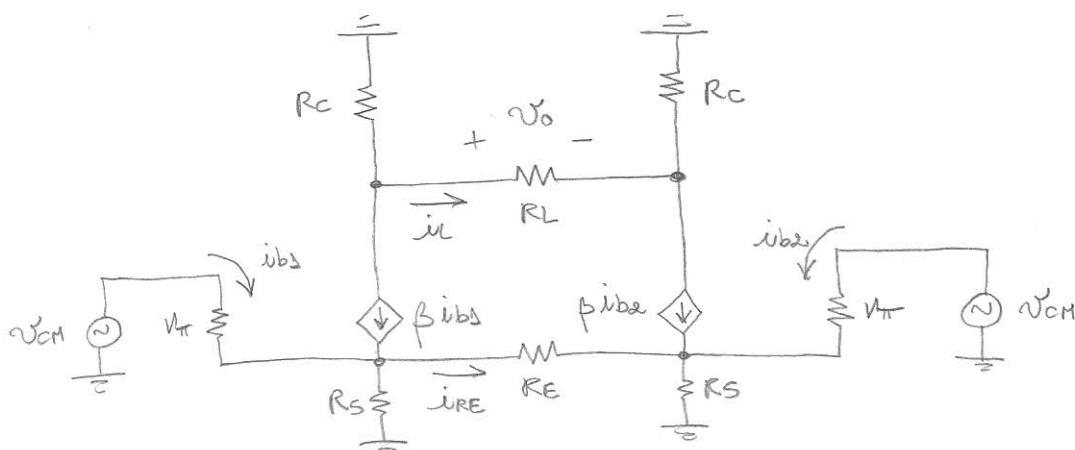
$$\Rightarrow A_v = \frac{v_o}{v_d} = \frac{v_{os} - v_{od}}{v_d} = -\frac{\beta R_C \parallel \frac{R_L}{2}}{\sqrt{\pi} + (\beta+1) \frac{R_E}{2}} = -25,4 \text{ V/V}$$

A impedância diferencial de entrada será dada por:

$$R_{id} = \frac{v_d}{i_{bs}} = \frac{\frac{V_d}{2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi} + (\beta+1) \frac{R_E}{2}} \cdot \frac{V_d}{2}} = 2\sqrt{\pi} + (\beta+1) R_E$$

$$R_{id} = 24,94 \text{ k}\Omega$$

Para obter o ganho de modo comum, faremos:



Pela simetria do circuito, temos que  $i_L = i_{RE} = 0$ . Sendo assim, teremos:

$$v_o = i_L R_L = 0$$

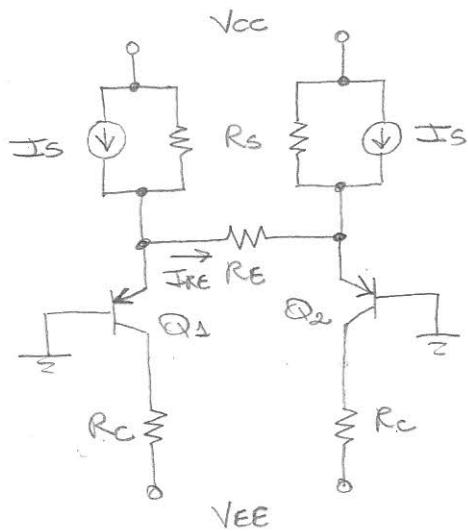
Então:

$$A_{vcm} = \frac{v_o}{v_{cm}} = 0$$

Portanto:

$$CMRR = \left| \frac{A_v}{A_{vcm}} \right| \rightarrow \infty$$

(b) Iniciaremos a análise pelos cálculos de pontos de operação:



Pela simetria do circuito, temos que o corrente  $I_{RE} = 0$ . Assim:

$$I_{E1} = I_{E2} = I_S + \frac{V_{CC} - V_{EB}}{R_S} = 0,094 \text{ mA}$$

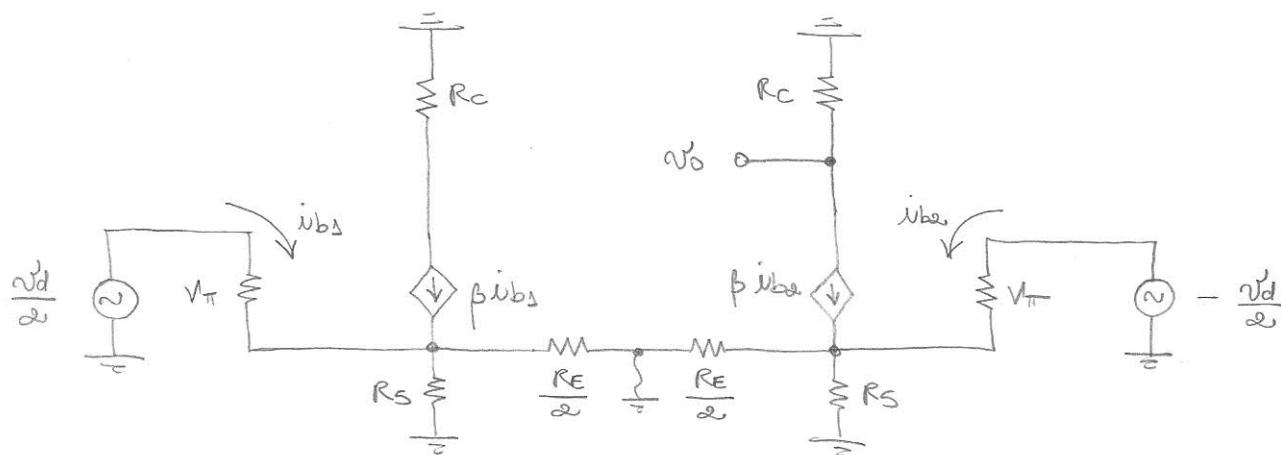
Logo:

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+1} I_{E1,2} = 0,073 \text{ mA}$$

Portanto, os parâmetros da opção. Isolais de Q1 e Q2 serão:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_m = \frac{I_C}{V_T} = 8d,9 \text{ mA/V} \\ V_\pi = \frac{\beta}{\alpha_m} = 1,25 \text{ k}\Omega \end{array} \right.$$

Assim, para o cálculo do ganho diferencial faremos:



Devido à simetria do circuito, temos a terra virtual apresentada acima. Nessa forma:

$$-\frac{V_d}{2} = V_\pi i_{be} + (\beta+1) i_{be} \frac{R_E}{2} // R_S \therefore i_{be} = -\frac{1}{V_\pi + (\beta+1) \frac{R_E}{2} // R_S} \cdot \frac{V_d}{2}$$

Então:

$$V_0 = -\beta i_{be} R_C = \frac{\beta R_C}{V_\pi + (\beta+1) \frac{R_E}{2} // R_S} \cdot \frac{V_d}{2}$$

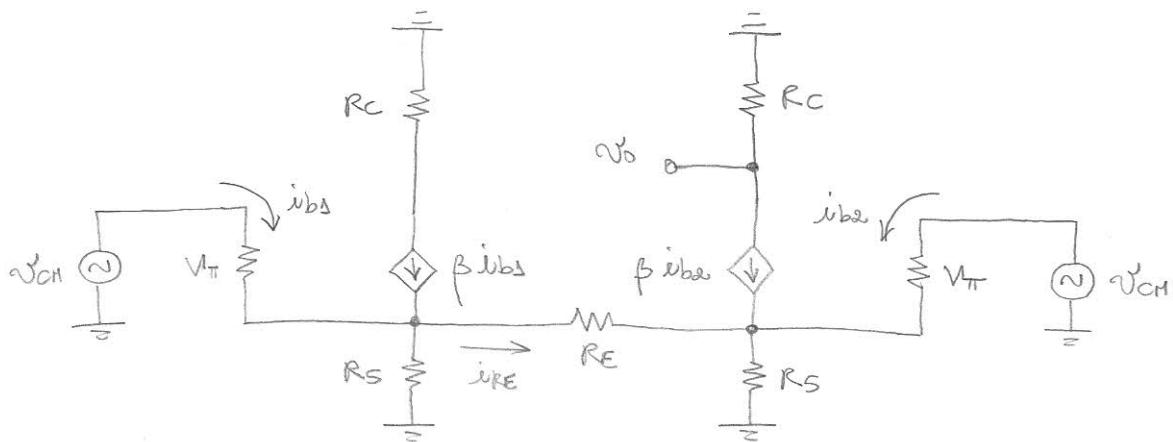
$$Avd = \frac{V_o}{V_{ld}} = \frac{\beta R_c}{\alpha V_T + (\beta+1) R_E // R_S} = 8,84 \text{ V/V}$$

Para obter a impedância de entrada diferencial, fazemos:

$$R_{ld} = \frac{V_{ld}}{I_{bds}} = \frac{\frac{V_{ld}}{1}}{\frac{V_T + (\beta+1) R_E // R_S}{2}} = \alpha V_T + (\beta+1) R_E // R_S$$

$$R_{ld} = 22,62 \text{ k}\Omega$$

Para obter o ganho de tensão de modo comum, fazemos a seguinte análise:



Pela simetria do circuito, temos que a corrente  $i_{RE} = 0$ .  
Sendo assim, teremos que:

$$V_{CM} = V_T i_{be} + (\beta+1) i_{be} R_S \therefore i_{be} = \frac{1}{V_T + (\beta+1) R_S} V_{CM}$$

Logo:

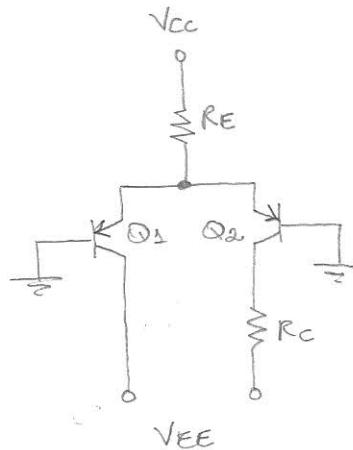
$$V_o = - \beta i_{be} R_c = - \frac{\beta R_c}{V_T + (\beta+1) R_S} V_{CM}$$

$$\Rightarrow Av_{CM} = \frac{V_o}{V_{CM}} = - \frac{\beta R_c}{V_T + (\beta+1) R_S} = - 0,0198 \text{ V/V}$$

Então:

$$CMRR = \left| \frac{Avd}{Av_{CM}} \right| = 446,5 = 53 \text{ dB}$$

(c) Comegamos a análise pelo cálculo dos pontos de operação DC:



Supondo Q1 e Q2 idênticos:

$$I_{ES} = I_{EE} = \frac{1}{2} \left[ \frac{V_{CC} - V_{EB}}{R_E} \right] = 1 \text{ mA}$$

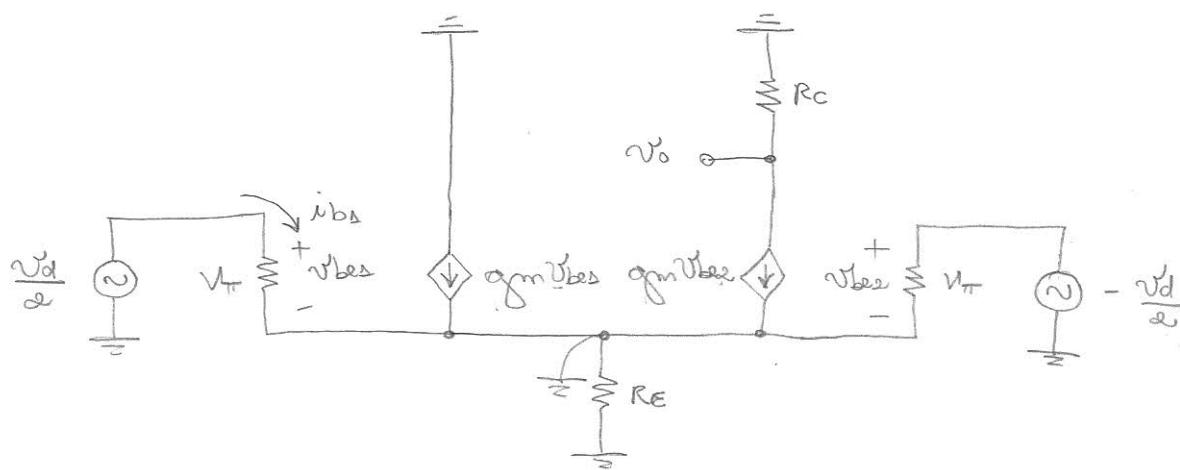
Então:

$$I_{CS} = I_{CE} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{ES,2} = 0,99 \text{ mA}$$

Nessa forma, os parâmetros do modelo de Ieq. Sinais serão dados por:

$$\begin{cases} \alpha_{pm} = \frac{I_C}{V_T} = 39,6 \text{ mA/V} \\ V_T = \frac{1}{\beta} = 2,52 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

Para obter o ganho diferencial, fazemos a seguinte análise:



Devido à simetria do circuito, temos a terra virtual apresentada acima. Sendo assim:

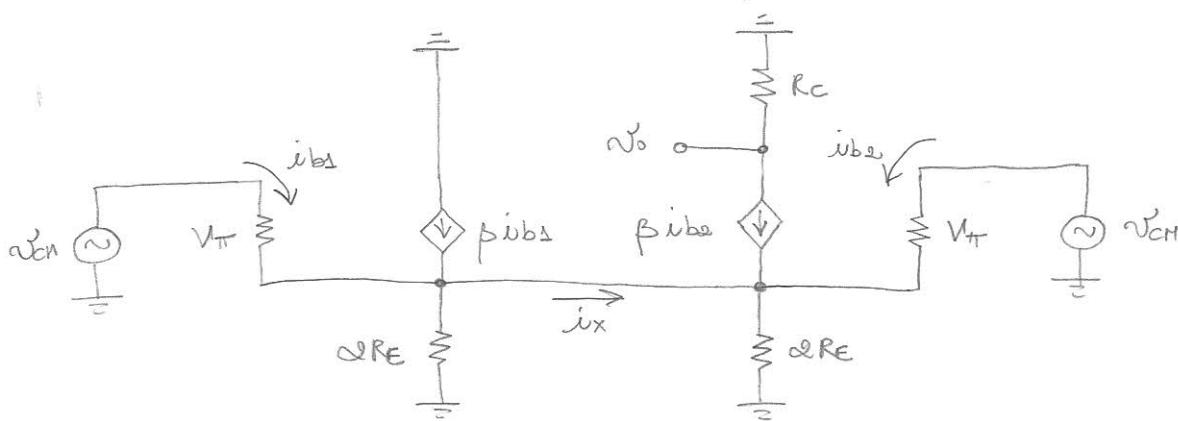
$$V_o = - \alpha_{pm} V_{BEE} R_C = - \alpha_{pm} \left( - \frac{V_d}{2} \right) R_C$$

$$\Rightarrow A_{vd} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{1}{2} \alpha_{pm} R_C = 39,6 \text{ V/V}$$

Para a impedância de entrada, devemos obter  $i_{bs}$ :

$$R_{id} = \frac{V_d}{i_{bs}} = \frac{\frac{V_d}{\alpha V_T}}{\frac{\frac{V_d}{\alpha}}{V_T}} = \alpha V_T = 5,04 \text{ k}\Omega$$

Para obter o ganho de modo comum, faremos a seguinte análise:



Em virtude da simetria do circuito, temos que  $i_x = 0$ .  
Sendo assim:

$$V_{cm} = V_T i_{be} + (\beta + \delta) i_{be} \alpha R_E \therefore i_{be} = \frac{1}{V_T + (\beta + \delta) \alpha R_E} V_{cm}$$

Então:

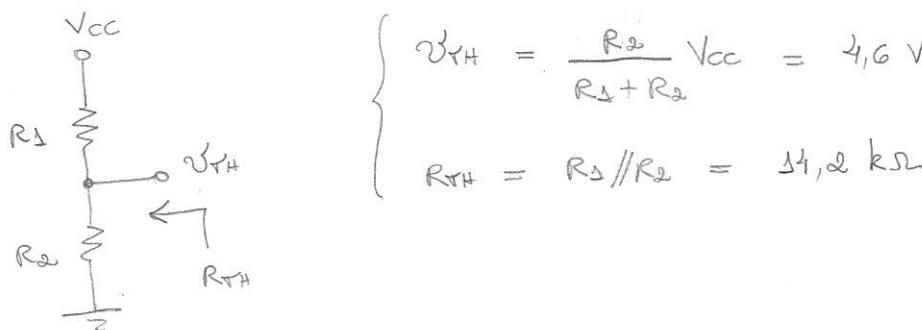
$$V_o = -\beta i_{be} R_C = -\frac{\beta R_C}{V_T + \alpha R_E (\beta + \delta)} V_{cm}$$

$$\Rightarrow A_{vcm} = \frac{V_o}{V_{cm}} = -\frac{\beta R_C}{V_T + \alpha R_E (\beta + \delta)} = -0,448 \text{ V/V}$$

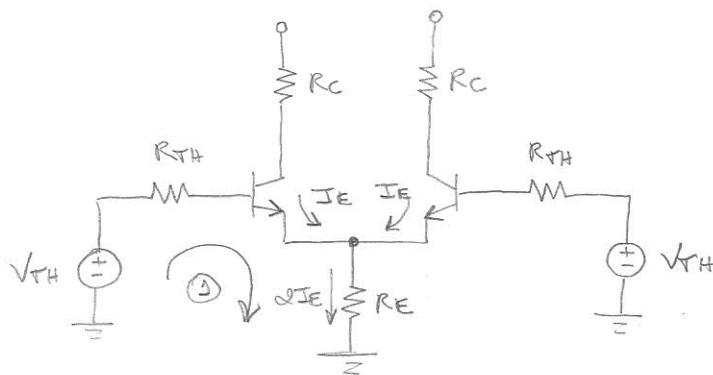
Portanto:

$$CHRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vcm}} \right| = 146,98 \cong 45 \text{ dB}$$

(d) Começaremos a análise pelos cálculos do ponto de operações DC. Para simplificar a análise, façamos o equivalente de Thévenin do circuito de polarizações da base:



Assim, o circuito de polarizações fica da seguinte forma:



Considerando o circuito simétrico, temos:  
 $I_{E1} = I_{E2} = I_E$

Escrivendo as equações de malha ④:

$$V_{TH} - R_{TH} I_B - V_{BE} - R_E (\alpha I_E) = 0$$

$$V_{TH} - R_{TH} I_B - V_{BE} - \alpha R_E (\beta + \Delta) I_B = 0$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + \alpha R_E (\beta + \Delta)} = 9,56 \mu\text{A}$$

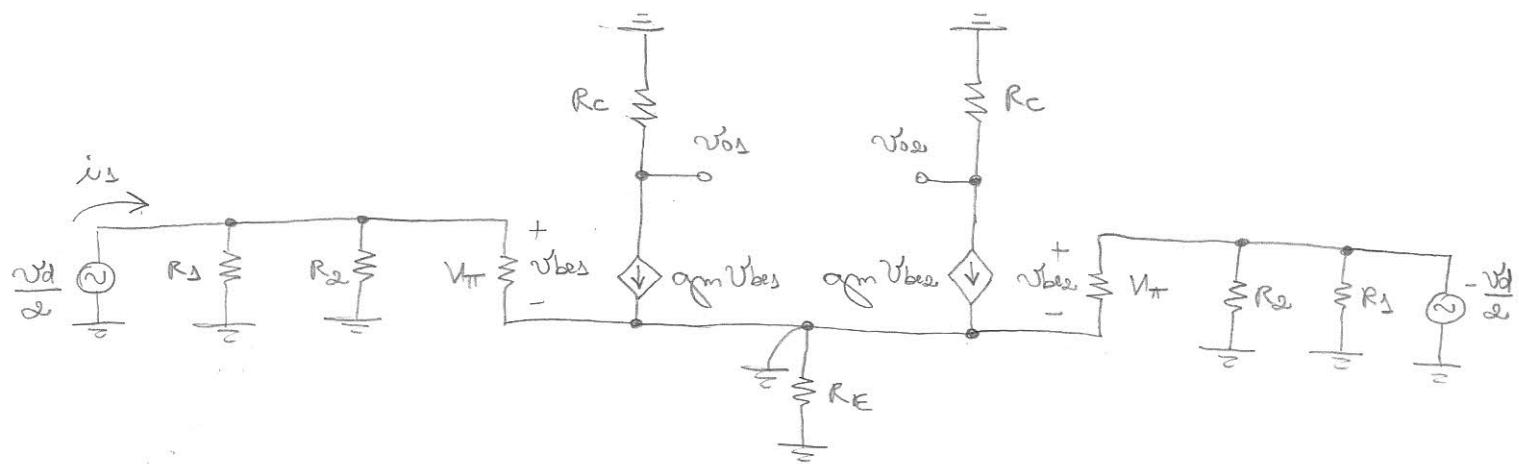
Sendo assim:

$$I_{C1} = I_{C2} = \beta I_B = 0,956 \text{ mA}$$

Com isso, os parâmetros de operação sinusoidal dos transistores são:

$$\left\{ \begin{array}{l} g_m = \frac{I_C}{V_T} = 38,3 \text{ mA/V} \\ V_T = \frac{\beta}{g_m} = 0,63 \text{ k}\Omega \end{array} \right.$$

Assim, para o cálculo do ganho diferencial, façamos a seguinte análise:



Devido à simetria do circuito, temos a terra virtual apresentada no circuito acima. Dessa forma:

$$\begin{cases} V_{os1} = - \text{gm} V_{bes} R_c = - \text{gm} \frac{V_d}{2} R_c \\ V_{os2} = - \text{gm} V_{bes} R_c = - \text{gm} \left( -\frac{V_d}{2} \right) R_c \end{cases}$$

Então:

$$A_{vd} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{V_{os1} - V_{os2}}{V_d} = - \text{gm} R_c = - 153,2 \text{ V/V}$$

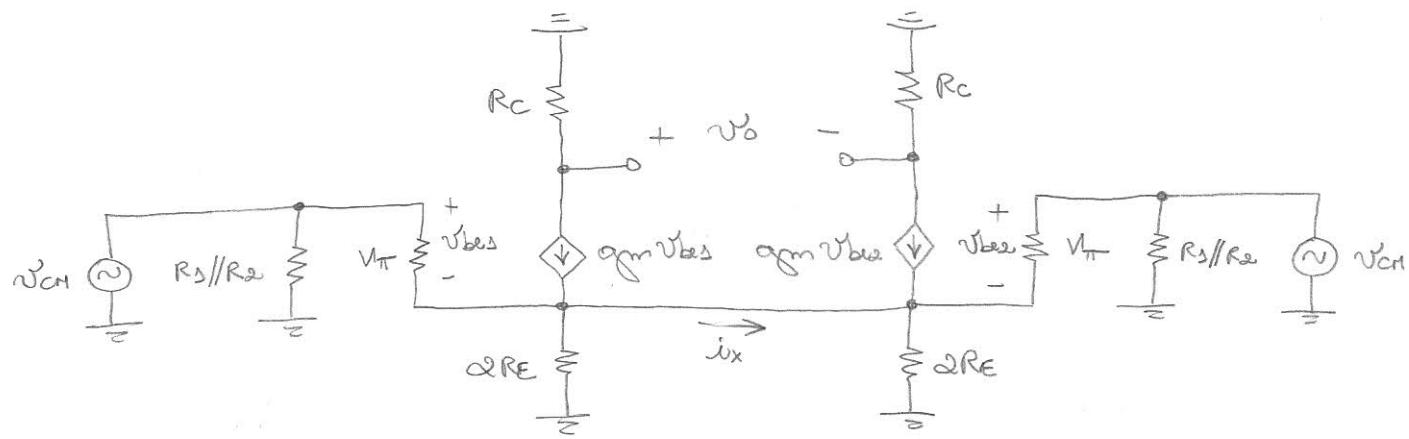
A impedância diferencial de entrada é obtida calculando-se o corrente  $i_{is}$  a partir das equações do nó de entrada:

$$i_{is} = \frac{\frac{V_d}{2}}{R_1} + \frac{\frac{V_d}{2}}{R_2} + \frac{\frac{V_d}{2}}{V_\pi}$$

$$i_{is} = \frac{V_d}{2R_1} + \frac{V_d}{2R_2} + \frac{V_d}{2V_\pi} = \frac{V_d}{2(R_1 \parallel R_2 \parallel V_\pi)}$$

$$\Rightarrow r_{id} = \frac{V_d}{i_{is}} = 2(R_1 \parallel R_2 \parallel V_\pi) = 4,4 \text{ k}\Omega$$

Para obter o agm de modo comum, analisamos o seguinte circuito:



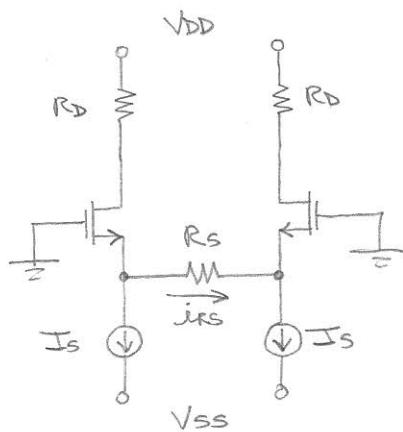
Como o circuito é simétrico, é natural que  $i_x = 0$ . Assim, podemos separar o circuito em duas metades iguais. Como as duas metades são iguais, então teremos  $V_o = 0$ . Portanto:

$$A_{VCM} = \frac{V_o}{V_{CM}} = 0$$

Então:

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vcm}} \right| \rightarrow \infty.$$

(e) Primeiramente, faremos a análise de pontos de operação DC do amplificador:



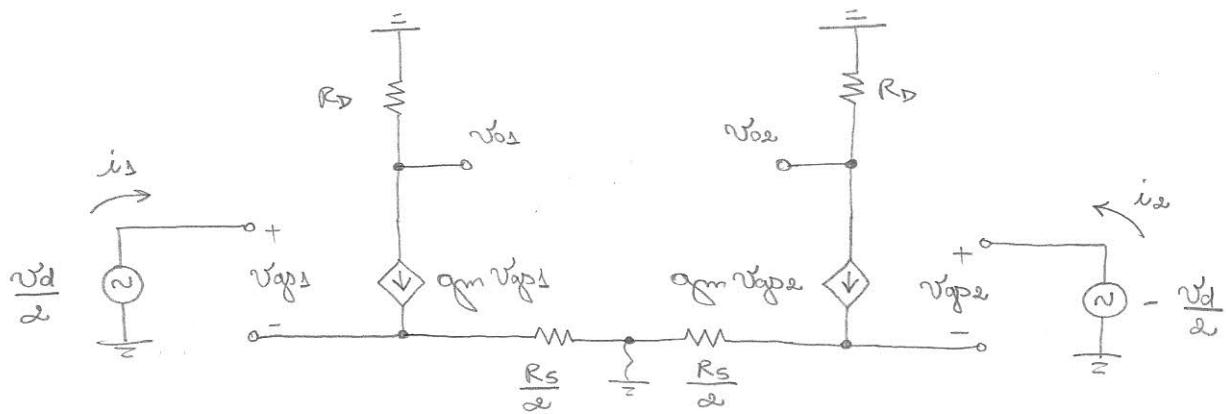
Pela simetria do circuito, é razoável supor que  $i_{DS} = 0$ . Sendo assim, temos que:

$$I_{D1} = I_{D2} = I_S = \alpha mA$$

Nessa forma, a transcondutância de sinal dos MOSFET's seria dada por:

$$\text{agm} = \sqrt{\alpha I_D k n \frac{W}{L}} = 4 \text{ mA/V}$$

Assim, para obtermos o agm diferencial, procedemos à seguinte análise:



Pela simetria dos circuitos, temos o teorema virtual apresentado na figura acima. Sendo assim:

$$V_{dps} = \frac{V_d}{2} - \alpha_m V_{dps} \frac{R_s}{2}$$

$$\left( 1 + \alpha_m \frac{R_s}{2} \right) V_{dps} = \frac{V_d}{2}$$

$$V_{dps} = \frac{1}{1 + \alpha_m \frac{R_s}{2}} \cdot \frac{V_d}{2}$$

Analogamente, temos:  $V_{dpe} = - \frac{1}{1 + \alpha_m \frac{R_s}{2}} \cdot \frac{V_d}{2}$

Então:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{ds} = - \alpha_m V_{dps} R_D = - \frac{\alpha_m R_D}{1 + \alpha_m \frac{R_s}{2}} \cdot \frac{V_d}{2} \\ V_{de} = - \alpha_m V_{dpe} R_D = + \frac{\alpha_m R_D}{1 + \alpha_m \frac{R_s}{2}} \cdot \frac{V_d}{2} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{ds} = - \alpha_m V_{dps} R_D = - \frac{\alpha_m R_D}{1 + \alpha_m \frac{R_s}{2}} \cdot \frac{V_d}{2} \\ V_{de} = - \alpha_m V_{dpe} R_D = + \frac{\alpha_m R_D}{1 + \alpha_m \frac{R_s}{2}} \cdot \frac{V_d}{2} \end{array} \right.$$

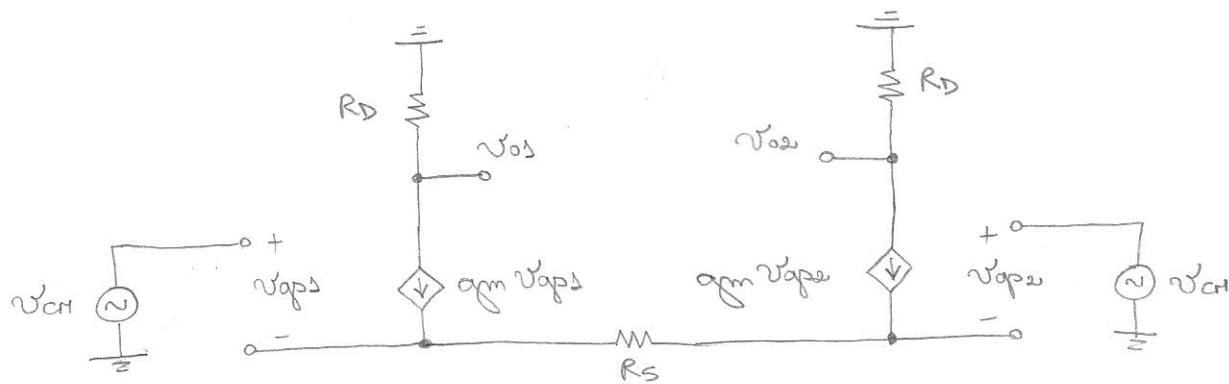
Portanto:

$$A_{vd} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{V_{ds} - V_{de}}{V_d} = - \frac{\alpha_m R_D}{1 + \alpha_m \frac{R_s}{2}} = - 2,86 \text{ V/V}$$

Como  $i_{is} = i_s = 0$ , temos que a impedância diferencial de entrada será infinita:

$$R_{id} \rightarrow \infty$$

Para obter o ganho de modo comum, procedemos à seguinte análise:



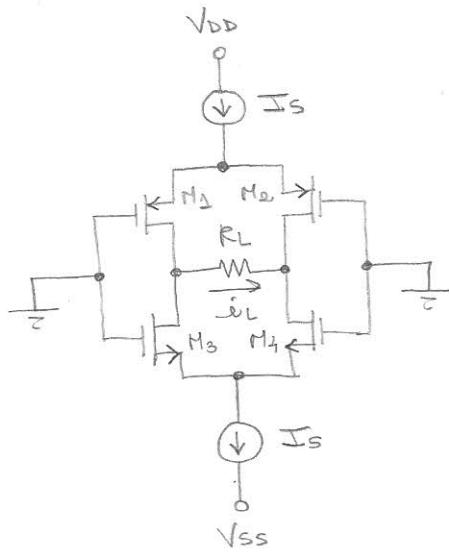
Como o circuito é simétrico, teremos  $V_{O1} = V_{O2}$ . Consequentemente:

$$A_{VCM} = \frac{V_o}{V_{CM}} = \frac{V_{O1} - V_{O2}}{V_{CM}} = 0$$

Assim, teremos:

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{VCM}} \right| \rightarrow \infty.$$

(f) Começamos a análise pelo cálculo das portas de operações DC:



Pela simetria do circuito,  $i_L = 0$ .

Sendo assim, teremos:

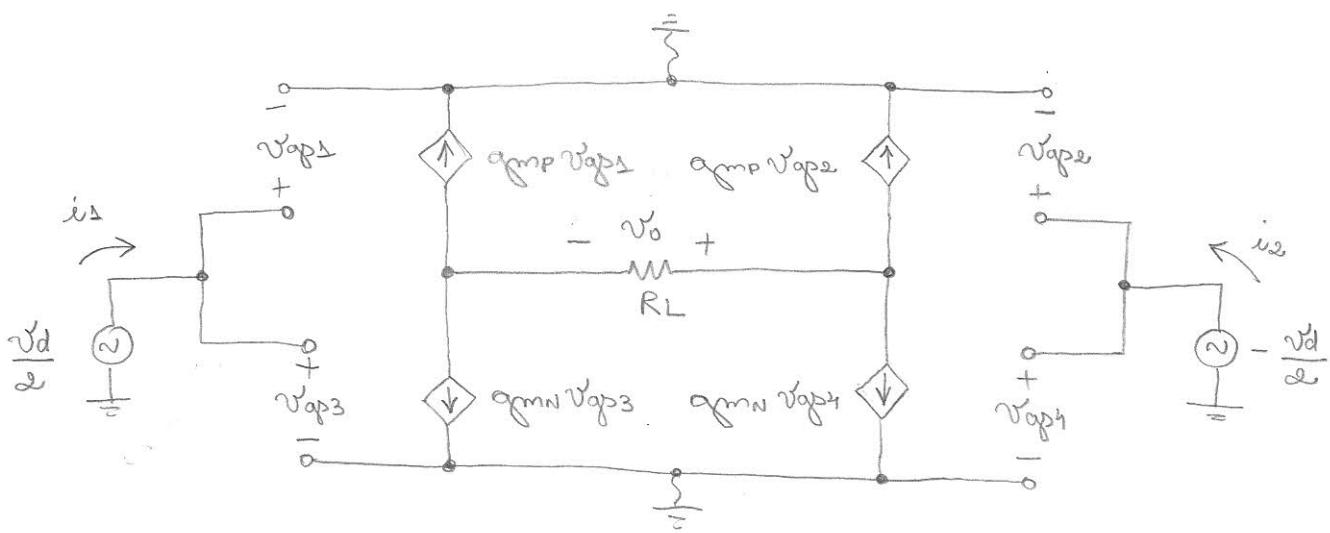
$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = I_{D4} = 1 \text{ mA}$$

Assim, as transcondutâncias de pequenos sinal serão dadas por:

$$\text{amp} = \sqrt{\alpha I_D k_p \frac{W}{L}} = \alpha \text{ mA/V}$$

$$\text{amp}_N = \sqrt{\alpha I_D k_n \frac{W}{L}} = \alpha \text{ mA/V}$$

Assim, podemos obter o ganho diferencial a partir da seguinte análise:



Dadas à simetria do circuito, teremos os dois teoremas virtuais apresentados na figura acima. Sendo assim:

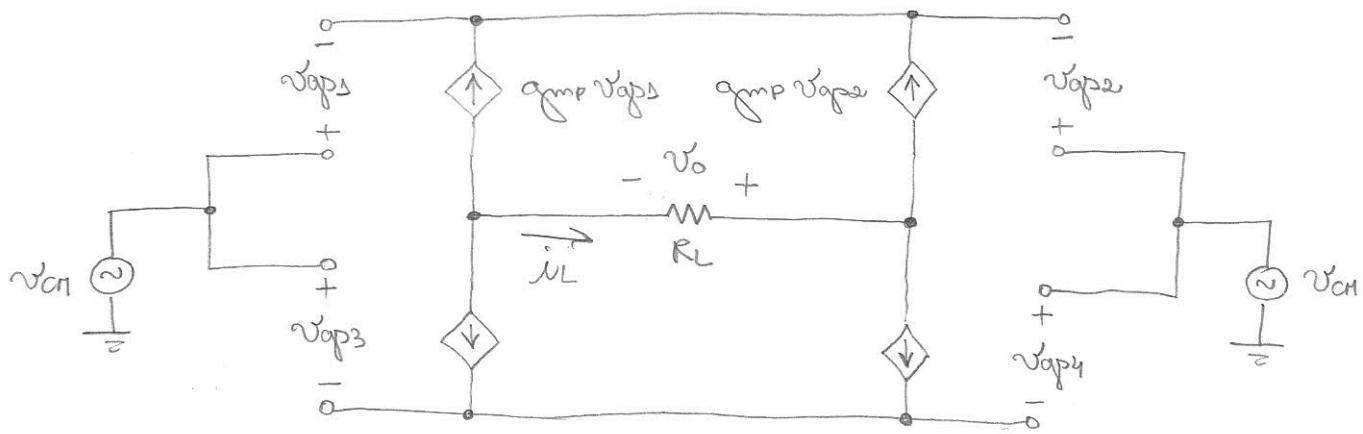
$$\begin{aligned}
 V_0 &= R_L \cdot \left( -g_{MN} V_{GP4} - g_{MP} V_{GP2} + g_{MN} V_{GP3} + g_{MP} V_{GP1} \right) = \\
 &= R_L \cdot \left( -g_{MN} \left( -\frac{V_d}{2} \right) - g_{MP} \left( -\frac{V_d}{2} \right) + g_{MN} \left( \frac{V_d}{2} \right) + g_{MP} \left( \frac{V_d}{2} \right) \right) = \\
 &= R_L (g_{MN} + g_{MP}) V_d
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A_{vd} = \frac{V_0}{V_d} = (g_{MN} + g_{MP}) \cdot R_L = 40 \text{ V/V}$$

Como  $i_s = i_e = 0$  no circuito acima, a impedância diferencial de entrada será:

$$R_{id} \rightarrow \infty.$$

Para a análise de modo comum, empregamos o seguinte modelo de pequenos sinal:



Dado à simetria do circuito, a corrente  $i_L = 0$ . Sendo assim, teremos:

$$V_0 = R_L \cdot i_L = 0$$

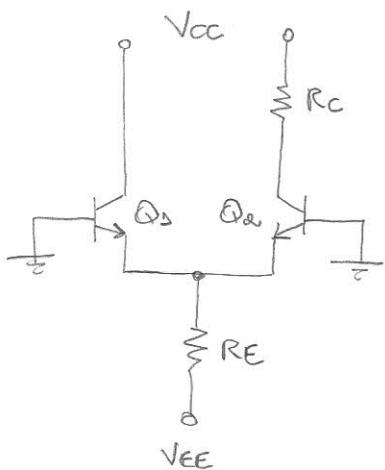
Então:

$$A_{VCM} = \frac{V_0}{V_{CM}} = 0$$

Consequentemente:

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{VCM}} \right| \rightarrow \infty$$

- ⑤ Começamos a análise pelo cálculo da ponte de operações DC do amplificador:



Considerando transistores perfeitamente casados, teremos:

$$I_{Es} = I_{Ea} = I_E$$

Assim:

$$\Delta I_E = \frac{-V_{EE} - V_{EE}}{R_E}$$

$$I_E = 1 \text{ mA}$$

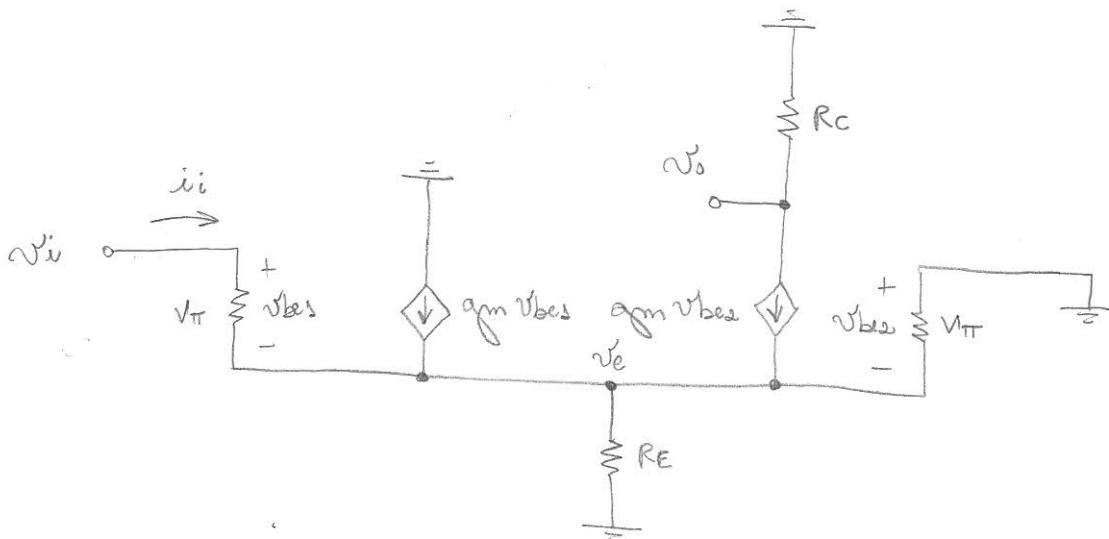
$I_{Ea}$ :

$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E = 0,99 \text{ mA}$$

Dessa forma, os parâmetros de sinal dos transistores são dados por:

$$g_{fm} = \frac{I_C}{V_T} = 39,6 \text{ mA/V} ; \quad V_{fT} = \frac{\beta}{g_{fm}} = 2,52 \text{ k}\Omega$$

A análise de pequenos sinais é realizada através de modelos apresentados a seguir:



Nesse caso, não é simétrico. dessa forma, escrevemos a equação da nó  $V_e$ :

$$\frac{V_e - V_i}{V_T} - \alpha_{gm} (V_i - V_e) - \alpha_{gm} (0 - V_e) + \frac{V_e}{R_E} + \frac{V_e}{V_T} = 0$$

$$V_e \left( \frac{\alpha}{V_T} + \alpha \alpha_{gm} + \frac{1}{R_E} \right) = V_i \left( \frac{1}{V_T} + \alpha_{gm} \right)$$

$$V_e \left[ \alpha \left( \frac{1 + \alpha_{gm} V_T}{V_T} \right) + \frac{1}{R_E} \right] = V_i \left( \frac{1 + \alpha_{gm} V_T}{V_T} \right)$$

$$V_e \left[ \alpha \left( \frac{1 + \beta}{V_T} \right) + \frac{1}{R_E} \right] = V_i \left( \frac{1 + \beta}{V_T} \right)$$

$$V_e \left[ \frac{\alpha R_E (\beta + 1)}{R_E \cdot V_T} + \frac{V_T}{V_T} \right] = V_i \frac{(\beta + 1)}{V_T}$$

$$V_e = \frac{R_E (\beta + 1)}{V_T + \alpha R_E (\beta + 1)} \cdot V_i$$

dessa forma:

$$V_o = - \alpha_{gm} V_{bes} R_C = - \alpha_{gm} (0 - V_e) R_C$$

$$V_o = \alpha_{gm} R_C \frac{R_E (\beta + 1)}{V_T + \alpha R_E (\beta + 1)} V_i$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{v_o}{v_i} = \alpha_{gm} R_C \frac{\frac{R_E(\beta+\Delta)}{V_T + \alpha R_E(\beta+\Delta)}}{= 98,17 \text{ V/V}}$$

Para obter a impedância de entrada, devemos calcular a corrente  $i_i$ :

$$i_i = \frac{v_i - v_e}{V_T} = \frac{1}{V_T} \left[ v_i - \frac{R_E(\beta+\Delta)}{V_T + \alpha R_E(\beta+\Delta)} v_i \right] = \\ = \frac{1}{V_T} \left[ \frac{V_T + R_E(\beta+\Delta)}{V_T + \alpha R_E(\beta+\Delta)} v_i \right] v_i$$

Então:

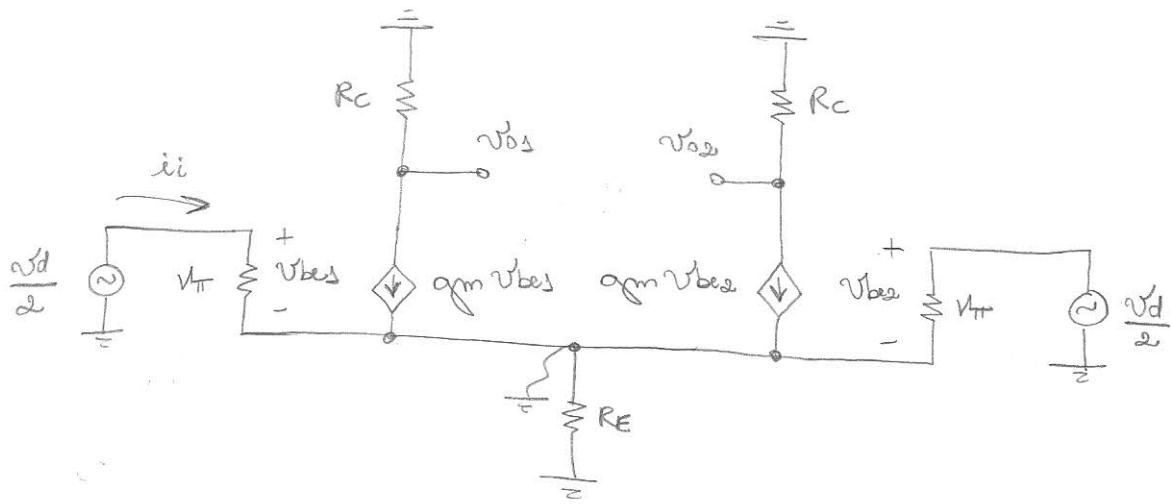
$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = V_T \left[ \frac{V_T + \alpha R_E(\beta+\Delta)}{V_T + R_E(\beta+\Delta)} \right] = \\ = V_T \left[ 1 + \frac{R_E(\beta+\Delta)}{V_T + R_E(\beta+\Delta)} \right] = \\ = V_T + \frac{V_T \cdot R_E(\beta+\Delta)}{V_T + R_E(\beta+\Delta)} = V_T + V_T // (R_E(\beta+\Delta))$$

$$R_i = 5,03 \text{ k}\Omega //$$

- ⑥ O primeiro passo de um projeto é realizar uma análise preliminar para obter expressões analíticas referente as que é pedido nas especificações.

Portanto, na análise realizada a seguir, vamos obter o ganho e a impedância de entrada diferencial dos amplificadores propostos.

O ganho é obtido a partir da seguinte análise de pequenos sinais:



Com virtude da simetria do circuito, temos a terra virtual apresentada acima. Sendo assim:

$$\begin{cases} V_{os} = - \alpha_{fm} V_{be1} R_c = - \alpha_{fm} \left(\frac{V_d}{2}\right) R_c = -\frac{1}{2} \alpha_{fm} R_c V_d \\ V_{oe} = - \alpha_{fm} V_{be2} R_c = - \alpha_{fm} \left(-\frac{V_d}{2}\right) R_c = +\frac{1}{2} \alpha_{fm} R_c V_d \end{cases}$$

Então:

$$A_{vd} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{V_{os} - V_{oe}}{V_d} = -\alpha_{fm} R_c$$

Para a impedância de entrada, calculamos a corrente ii:

$$ii = \frac{\frac{V_d}{2}}{V_T} \quad ; \quad ii = \frac{V_d}{\alpha V_T}$$

$$\text{Logo: } R_{id} = \frac{V_d}{ii} = \alpha V_T = \alpha \frac{\beta}{\alpha_{fm}} = \alpha \beta \frac{V_T}{I_C}$$

Como foi especificado  $R_{id} \geq 5k\Omega$  com  $\beta$  variando de 100 a 800, faremos:

$$R_{id} = \alpha \beta \frac{V_T}{I_C} \geq 5k\Omega$$

$$\text{Assim: } \alpha \cdot 100 \cdot \frac{0,025}{I_C} = 5 \quad \therefore I_C = \frac{100 \cdot 0,025}{5} \\ I_C = 1 \text{ mA}$$

Nessa forma, se  $\beta > 100$ , então  $R_{id} > 5k\Omega$ .

Com  $I_C = 5 \text{ mA}$ , então:

$$g_m = \frac{Ic}{Vt} = 40 \text{ mA/V}$$

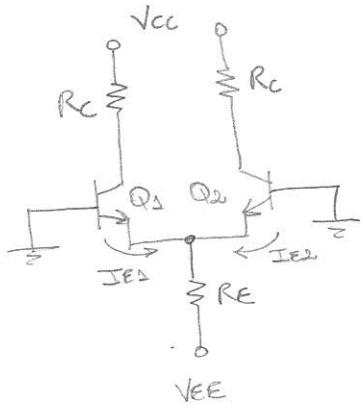
Consequentemente, podemos calcular  $R_c$  a partir da especificação de agudos:

$$|Avd| = \text{avg } R_C = 120$$

$$40 \text{ RC} = 500$$

$$R_C = 3 k\Omega$$

é calculado para produzir a corrente de gás o resistor  $R_E$  é calculado para produzir a corrente de sinalização DC:



considerando os transistores perfeitamente casados, temos:

$$(-V_{BE} - V_{EE}) = R_E (I_{E1} + I_{E2}) = \alpha I_E R_E$$

$$\text{and: } I_E = I_{ES} = I_{ED}$$

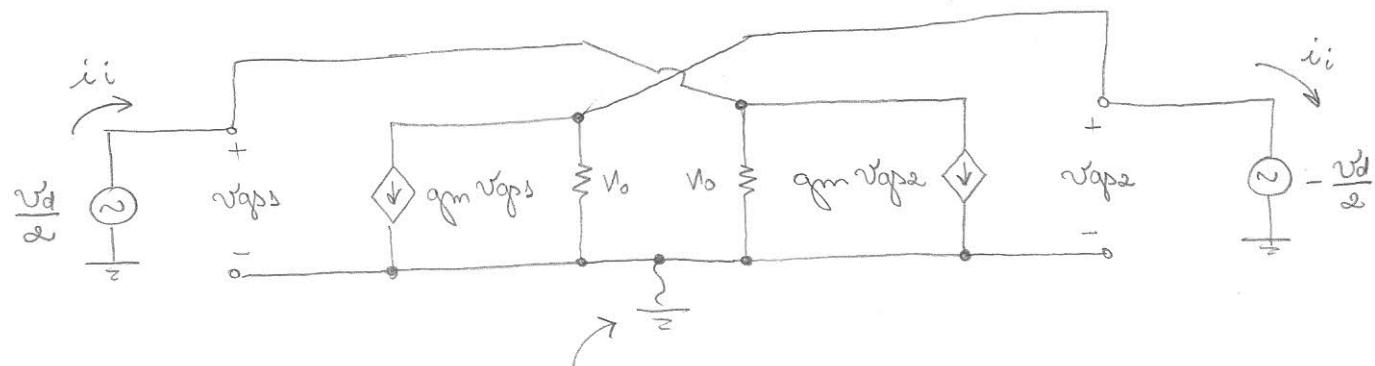
Entas :

$$R_E = \frac{-V_{BE} - V_{EE}}{2I_E}$$

Considerando  $I_C \approx I_E$ , então  $I_C \approx 1 \text{ mA}$ . Assim:

$$R_E = 4,7 \text{ k}\Omega$$

- ④ Para obter a impedância de entrada diferencial, usamos o seguinte modelo:



Terra virtual, em virtude da simetria do circuito.

Para obter a impedância de entrada diferencial, devemos calcular  $i_{ii}$ :

$$i_{ii} = \frac{\frac{v_d}{2}}{V_0} + \text{gpm } v_{o2} = -\frac{\frac{v_d}{2}}{V_0} + \text{gpm } \left(-\frac{v_d}{2}\right)$$

$$i_{ii} = \left[ \frac{1}{2V_0} - \frac{\text{gpm}}{2} \right] v_d$$

Então:

$$R_{id} = \frac{v_d}{i_{ii}} = \frac{1}{\frac{1}{2V_0} - \frac{\text{gpm}}{2}}$$

Como  $V_0 \gg \frac{1}{\text{gpm}}$ , então:

$$\boxed{R_{id} \approx -\frac{2}{\text{gpm}}}$$

Esse é um exemplo de como sintetizar uma resistência negativa.